

英飞凌MOSFET

金属氧化物半导体场效应晶体管

CFDA 汽车级

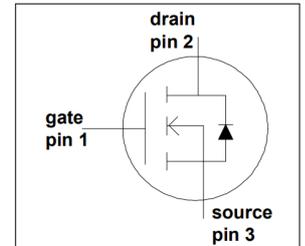
650V CoolMOS™ CFDA 功率管 IPx65R110CFDA

数据手册

Rev. 2.0
最终

1 描述

CoolMOS™ 是高压功率 MOSFET 的革命性技术，根据超结 (SJ) 原理设计，由英飞凌科技率先推出。650V CoolMOS™ CFDA 系列将领先的 SJ MOSFET 供应商的经验与顶尖创新技术相结合。由此产生的器件具有快速开关 SJ MOSFET 的所有优点，同时还具有极快和坚固的体二极管。这种极低的开关、换向和传导损耗与最高的坚固性相结合，使谐振开关应用特别可靠、高效、轻便和冷却。



特性

- 超快体二极管
- 出色的换向耐用性
- 极低损耗，因为 FOM $R_{ds(on)} \cdot Q_g$ 和 $R_{ds(on)} \cdot E_{oss}$ 值低
- 易于使用或驱动
- 符合 AEC-Q101 标准
- 绿色包装（符合 RoHS 规范），无铅电镀，模具化合物不含卤素



应用

650V CoolMOS™ CFDA 专为开关应用而设计。

表 1 主要性能参数

Parameter	Value	Unit
V_{DS}	650	V
$R_{DS(on),max}$	0.11	Ω
Q_g,typ	118	nC
$I_D,pulse$	99.6	A
$E_{oss} @ 400V$	9.2	μJ
Body diode di/dt	900	$A/\mu s$
Q_{rr}	0.8	μC
t_{rr}	150	ns
I_{rrm}	8.3	A

Type / Ordering Code	Package	Marking	Related Links
IPW65R110CFDA	PG-TO 247	65F6110A	-
IPB65R110CFDA	PG-TO 263		
IPP65R110CFDA	PG-TO 220		

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见，英飞凌提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性，请务必访问 [infineon.com](http://www.infineon.com) 参考最新的英文版本（控制文档）。

目录

描述	2
目录	3
最大额定值	4
热特性	5
电气特性	6
电气特性图	8
测试电路	12
封装外形	13
修订记录	16
免责声明	16

2 最大额定值

$T_j=25^\circ\text{C}$, 除非另有规定

表 2 最大额定值

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Continuous drain current ¹⁾	I_D			31.2	A	$T_C = 25^\circ\text{C}$
				19.7		$T_C = 100^\circ\text{C}$
Pulsed drain current ²⁾	$I_{D,pulse}$			99.6	A	$T_C = 25^\circ\text{C}$
Avalanche energy, single pulse	E_{AS}			845	mJ	$I_D = 6.2\text{A}$, $V_{DD} = 50\text{V}$ (see table 19)
Avalanche energy, repetitive	E_{AR}			1.3	mJ	$I_D = 6.2\text{A}$, $V_{DD} = 50\text{V}$
Avalanche current, repetitive	I_{AR}			6.2	A	
MOSFET dv/dt ruggedness	dv/dt			50	V/ns	$V_{DS} = 0 \dots 400\text{V}$
Gate source voltage	V_{GS}	-20		20	V	static
		-30		30		AC ($f > 1\text{Hz}$)
Power dissipation (non FullPAK, SMD) TO-247, TO-220, D ² PAK	P_{tot}			277.8	W	$T_C = 25^\circ\text{C}$
Operating and storage temperature	T_j, T_{stg}	-40		150	$^\circ\text{C}$	
Mounting torque (non FullPAK) TO-247, TO-220				60	Ncm	M3 and M3.5 screws
Continuous diode forward current	I_S			31.2	A	$T_C = 25^\circ\text{C}$
Diode pulse current	$I_{S,pulse}$			99.6	A	$T_C = 25^\circ\text{C}$
Reverse diode dv/dt ³⁾	dv/dt			50	V/ns	$V_{DS} = 0 \dots 400\text{V}$, $I_{SD} \leq I_D$, $T_j = 25^\circ\text{C}$ (see table 17)
Maximum diode commutation speed	di_r/dt			900	A/ μs	

¹⁾ 受 $T_{j,max}$ 限制。

²⁾ 脉冲宽度 t_p 受 $T_{j,max}$ 限制

³⁾ 相同的低侧和高侧开关，具有相同的 R_θ

3 热特性

表 3 热特性 TO-247, TO-220

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}			0.45	K/W	
Thermal resistance, junction - ambient	R_{thJA}			62	K/W	leaded
Soldering temperature, wavesoldering only allowed at leads	T_{sold}			260	°C	1.6 mm (0.063 in.) from case for 10s

表 4 热特性 D²PAK

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}			0.45	K/W	
Thermal resistance, junction - ambient ¹⁾	R_{thJA}			62	K/W	SMD version, device on PCB, minimal footprint
			35			SMD version, device on PCB, 6cm ² cooling area
Soldering temperature, wave- & reflowsoldering allowed	T_{sold}			260	°C	reflow MSL

¹⁾ 设备安装在 40mm*40mm*1.5mm 单层环氧树脂印刷电路板 FR4 上，漏极连接采用 6 cm²铜面积（厚度 70μm）。印刷电路板垂直放置，无气流冷却。

4 电气特性

$T_j=25^\circ\text{C}$, 除非另有规定

表 5 静态特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Drain-source breakdown voltage ¹⁾	$V_{(BR)DSS}$	650			V	$V_{GS} = 0V, I_D = 1mA$
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	3.5	4	4.5	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 1.3mA$
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}			1.5	μA	$V_{DS} = 650V, V_{GS} = 0V, T_j = 25^\circ C$ $V_{DS} = 650V, V_{GS} = 0V, T_j = 150^\circ C$
			400			
Gate-source leakage current	I_{GSS}			100	nA	$V_{GS} = 20V, V_{DS} = 0V$
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$		0.099	0.11	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 12.7A, T_j = 25^\circ C$ $V_{GS} = 10V, I_D = 12.7A, T_j = 150^\circ C$
			0.257			
Gate resistance	R_G		1.3		Ω	$f = 1MHz, \text{open drain}$

表 6 动态特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Input capacitance	C_{iss}		3240		μF	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 100V, f = 1MHz$
Output capacitance	C_{oss}		160			
Effective output capacitance, energy related ²⁾	$C_{o(er)}$		120		μF	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 0 \dots 400V$
Effective output capacitance, time related ³⁾	$C_{o(tr)}$		553		μF	$I_D = \text{constant}, V_{GS} = 0V, V_{DS} = 0 \dots 400V$
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$		16		ns	$V_{DD} = 400V, V_{GS} = 13V, I_D = 19.1A, R_G = 1.8\Omega$ (see table 18)
Rise time	t_r		11			
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		68			
Fall time	t_f		6			

表 7 栅极电荷特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Gate to source charge	Q_{gs}		21		nC	$V_{DD} = 480V, I_D = 19.1A, V_{GS} = 0 \text{ to } 10V$
Gate to drain charge	Q_{gd}		64			
Gate charge total	Q_g		118			
Gate plateau voltage	$V_{plateau}$		6.4			

¹⁾对于施加的阻断电压> 指定阻断电压的65%的应用, 我们建议在早期设计阶段评估宇宙辐射效应的影响。如需评估, 请联系当地英飞凌销售办事处。

²⁾ $C_{o(er)}$ 是一个固定电容, 当 V_{DS} 从 0V 上升到 400V 时, 其存储的能量与 C_{oss} 相同

³⁾ $C_{o(tr)}$ 是一个固定电容, 当 V_{DS} 从 0V 上升到 400V 时, 其充电时间与 C_{oss} 相同

表8 反向二极管特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Diode forward voltage	V_{SD}		0.9		V	$V_{GS} = 0V, I_F = 19.1A, T_j = 25^\circ C$
Reverse recovery time	t_{rr}		150		ns	$V_R = 400V, I_F = 19.1A,$ $di_F/dt = 100A/\mu s$ (see table 17)
Reverse recovery charge	Q_{rr}		0.8		μC	
Peak reverse recovery current	I_{rrm}		8.3		A	

5 电气特性图

表 9

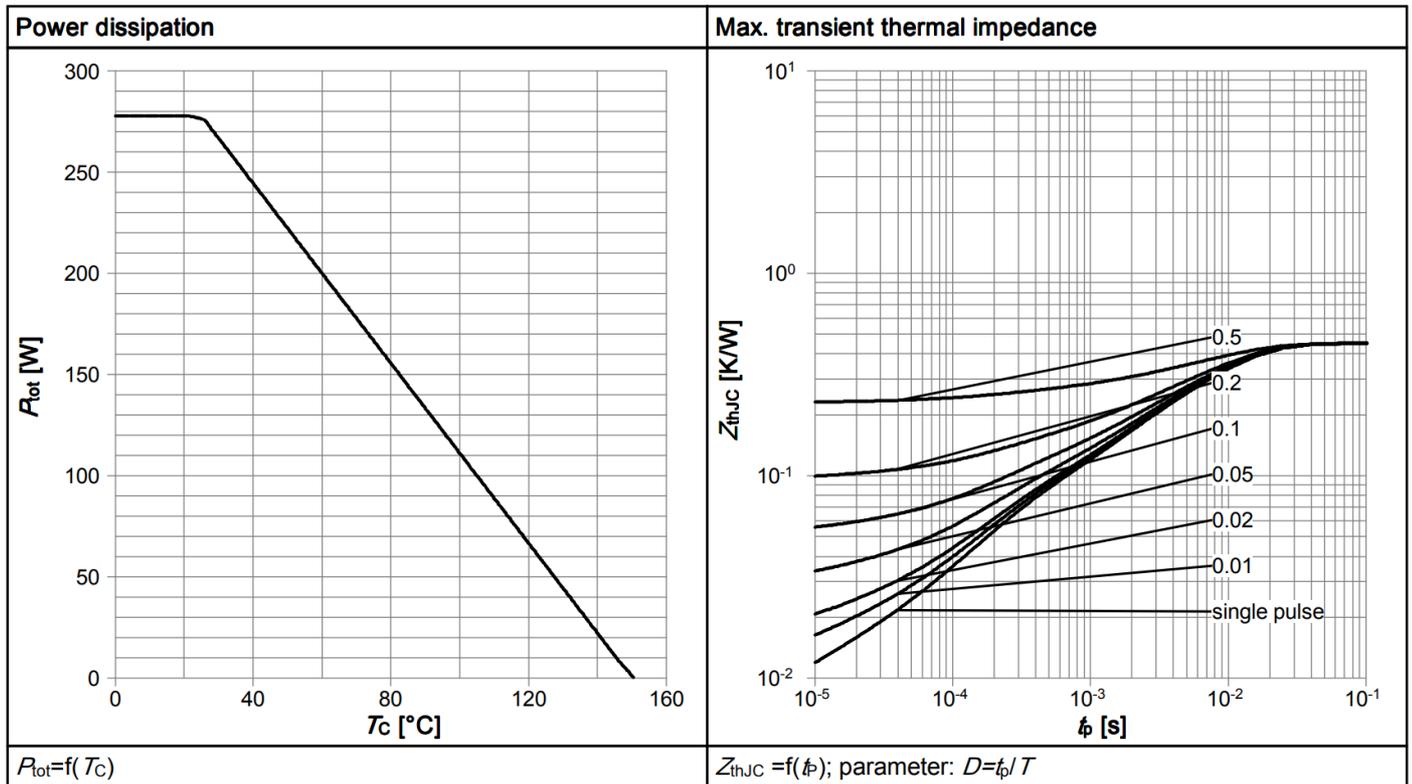


表 10

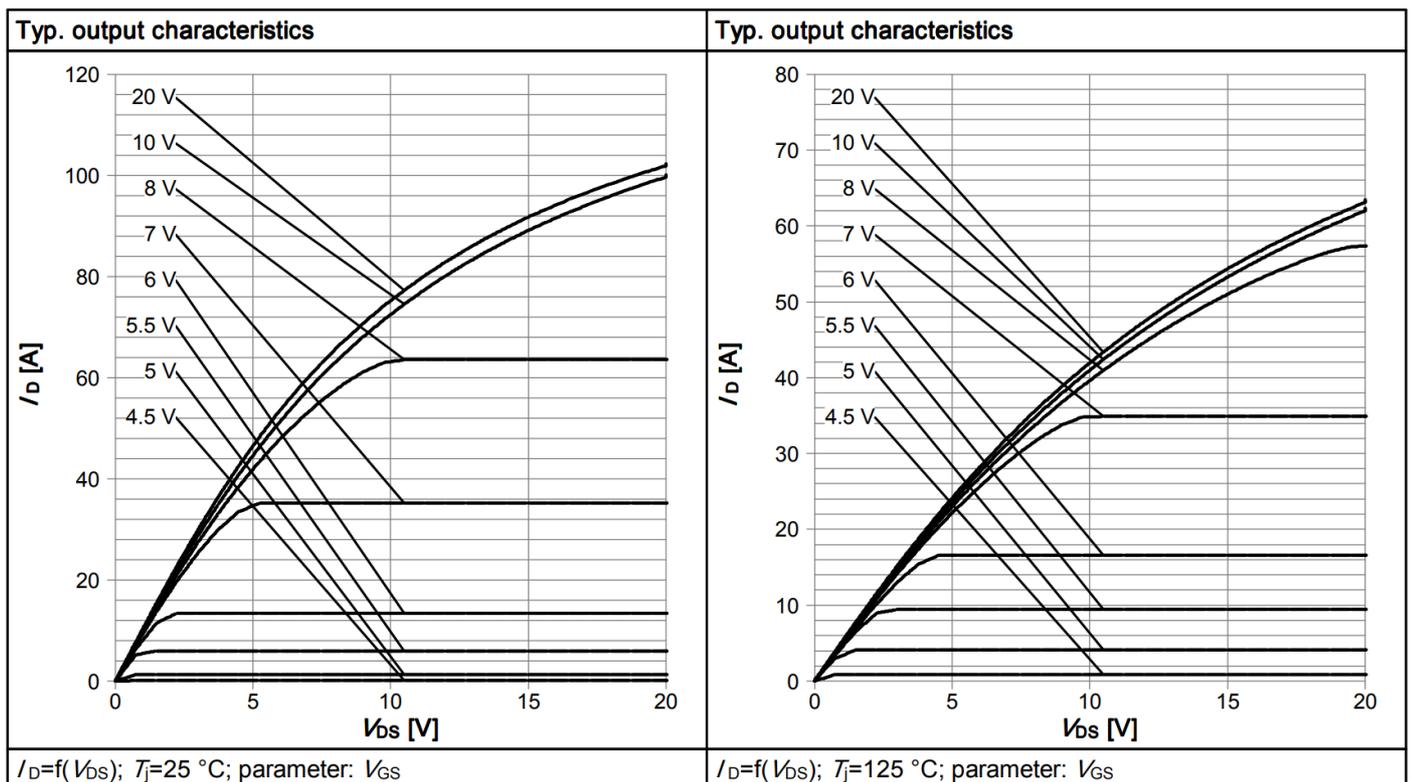


表 11

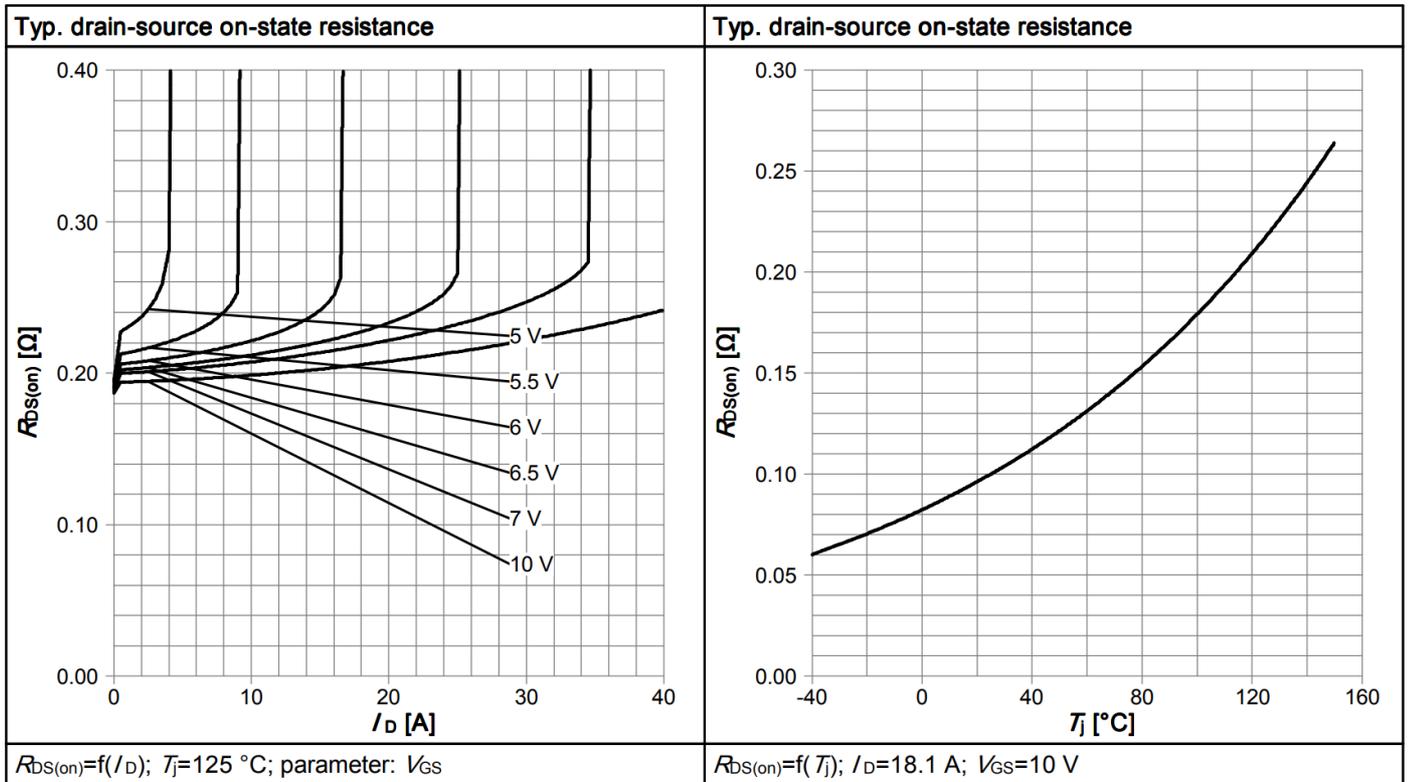


表 12

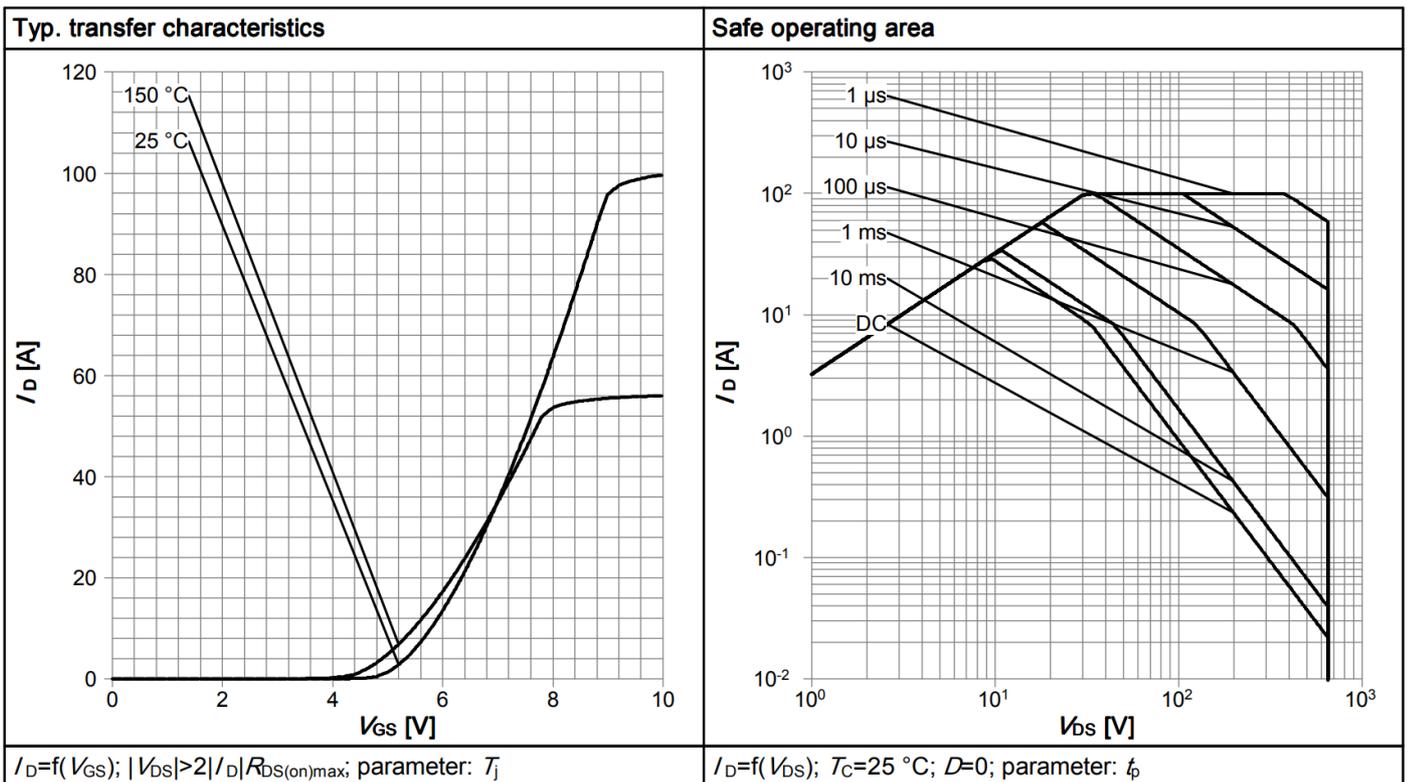


表 13

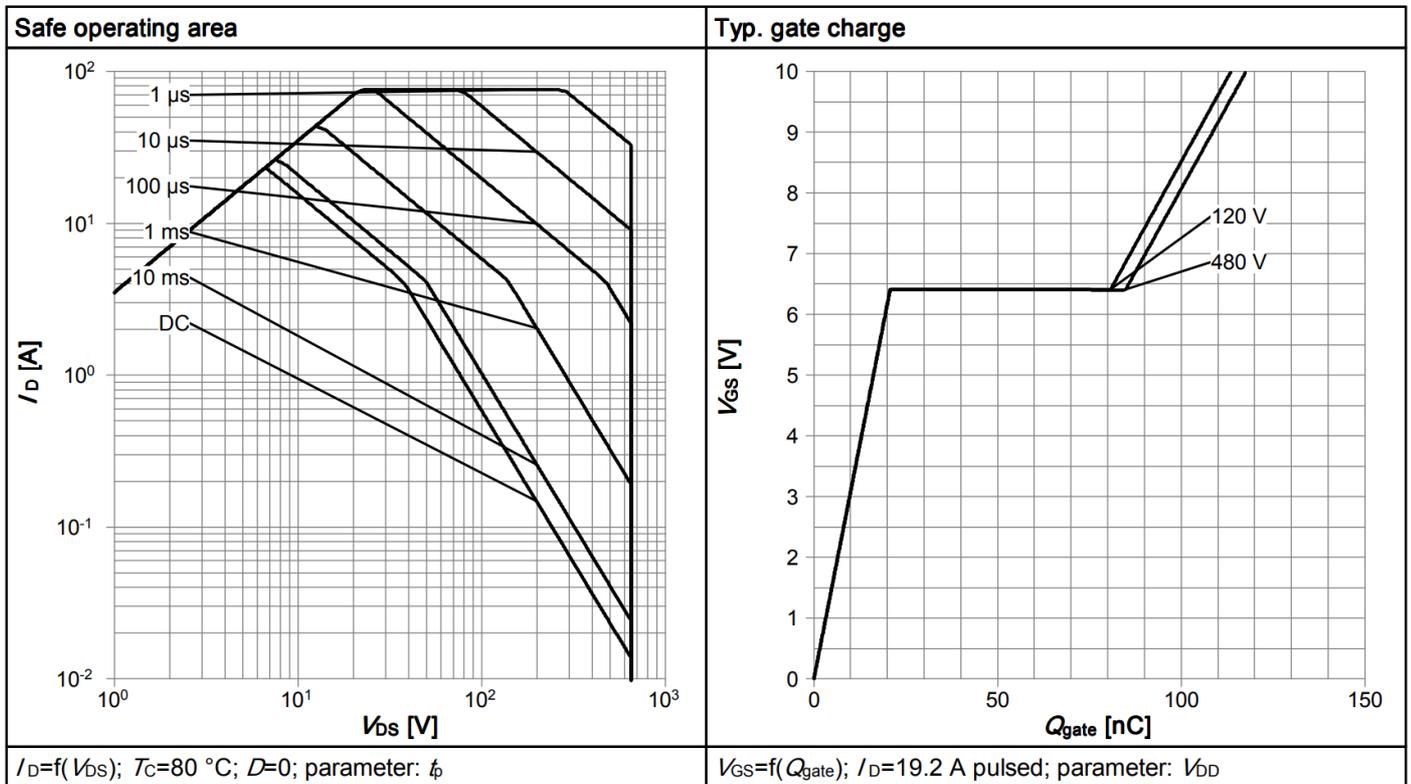


表 14

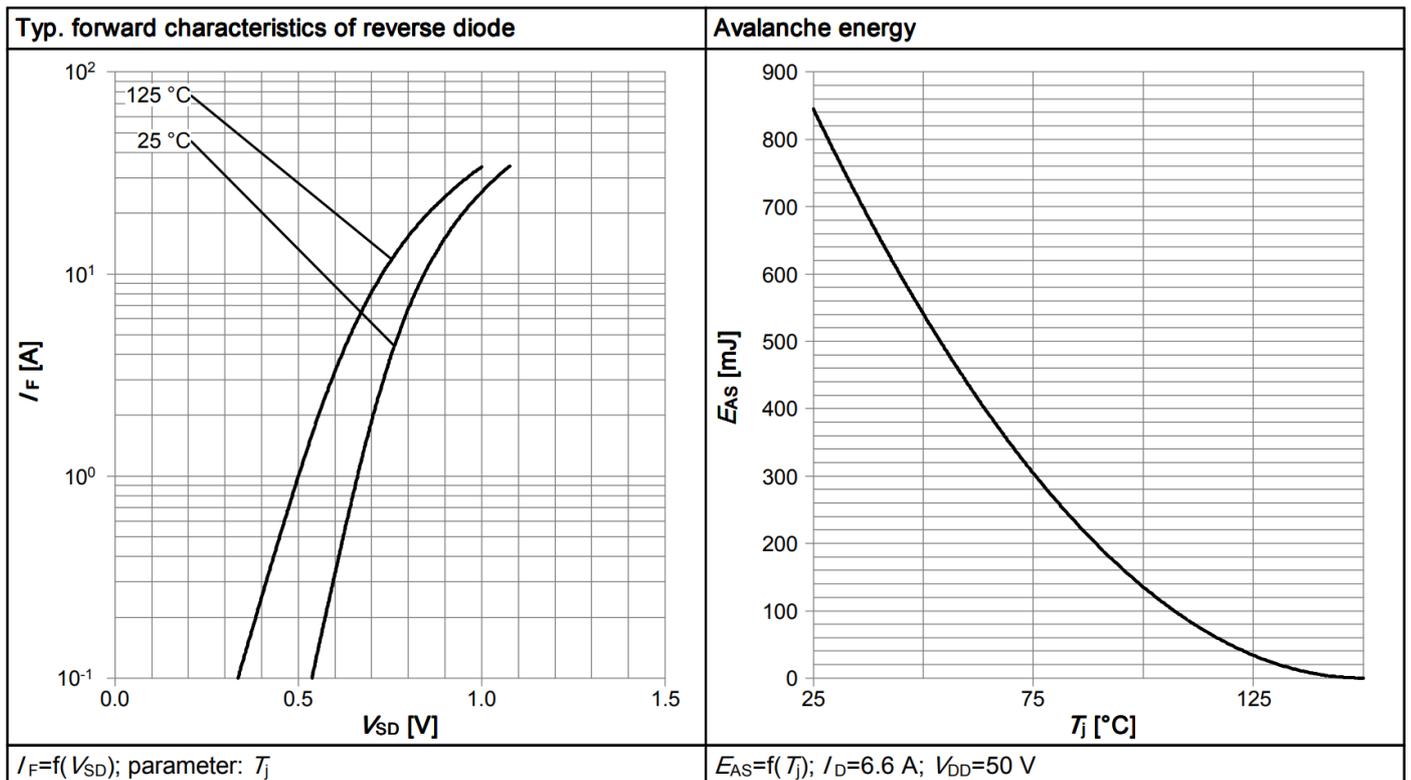


表 15

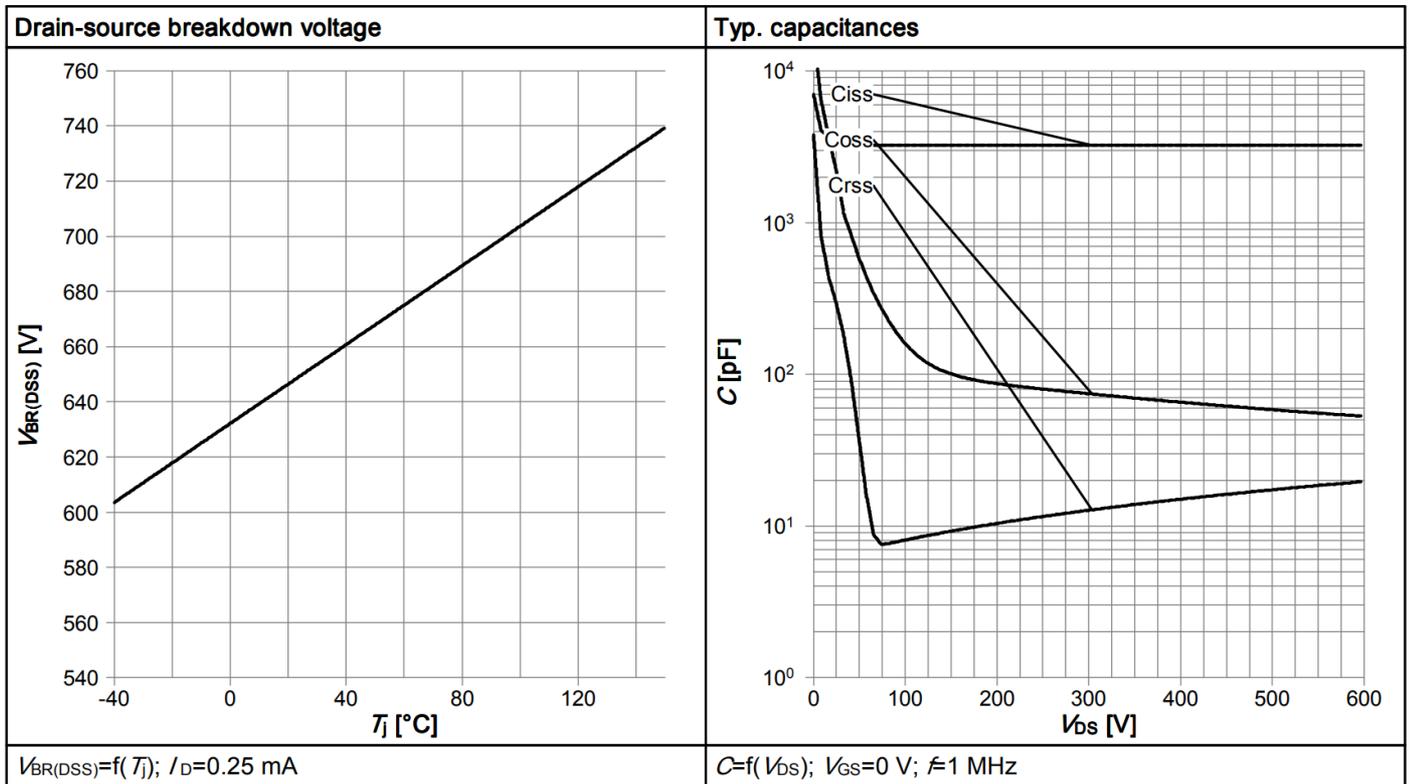
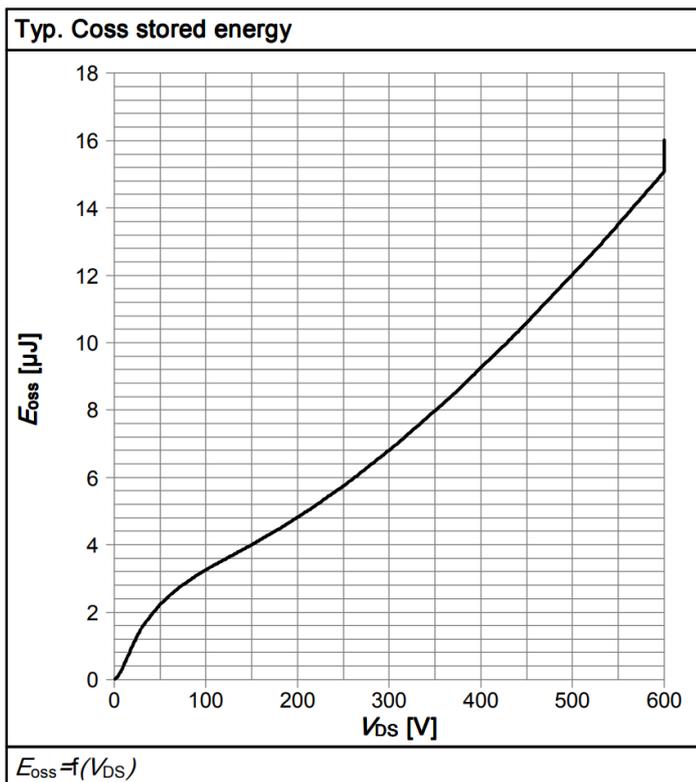
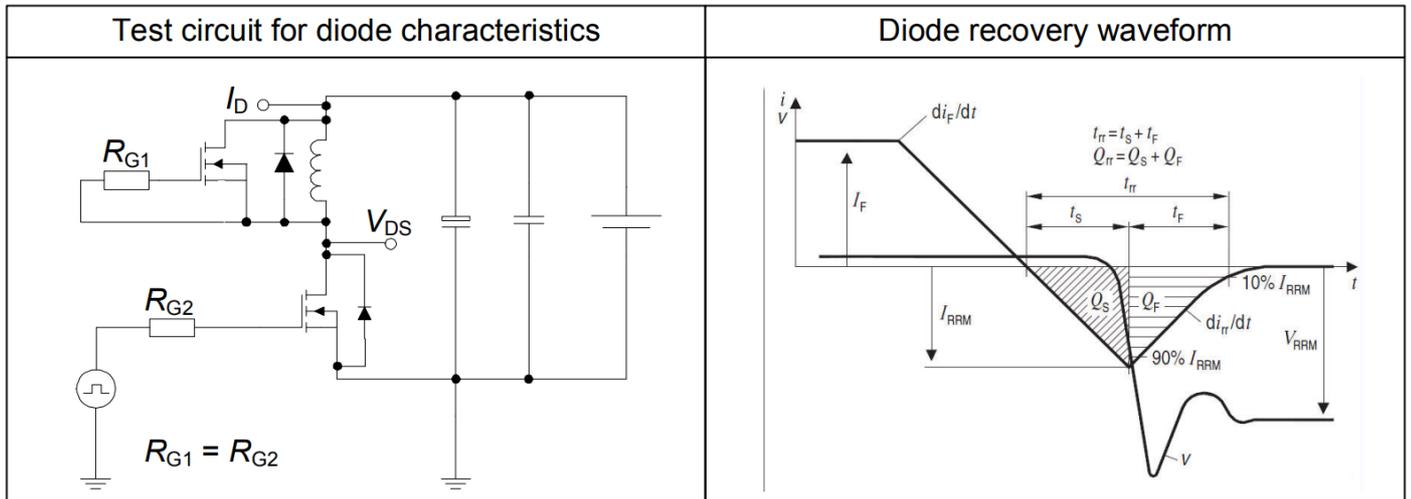
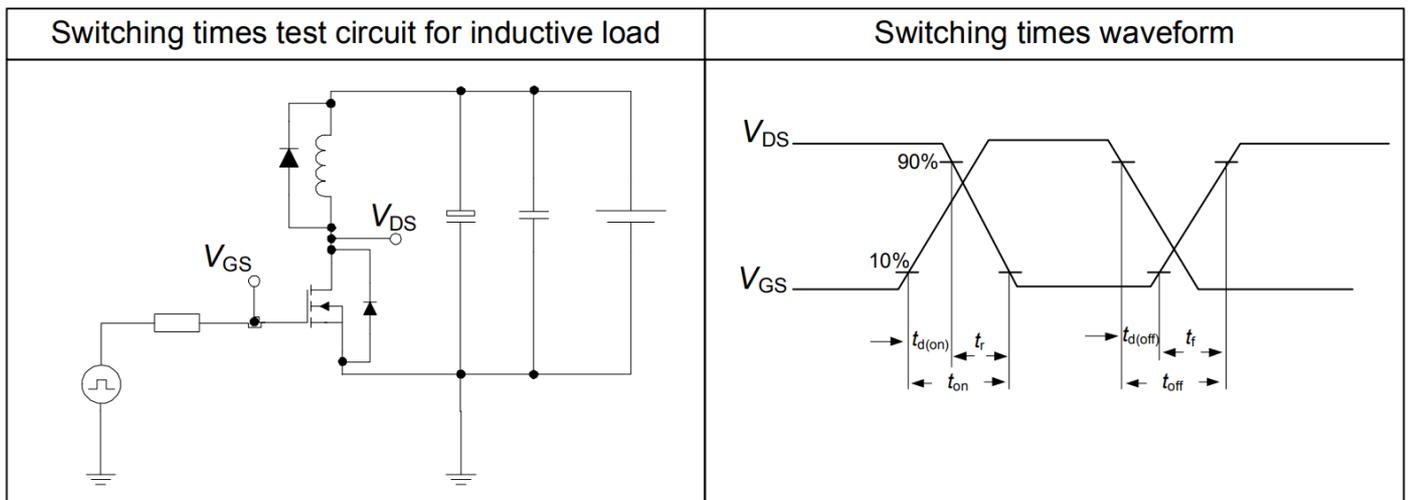
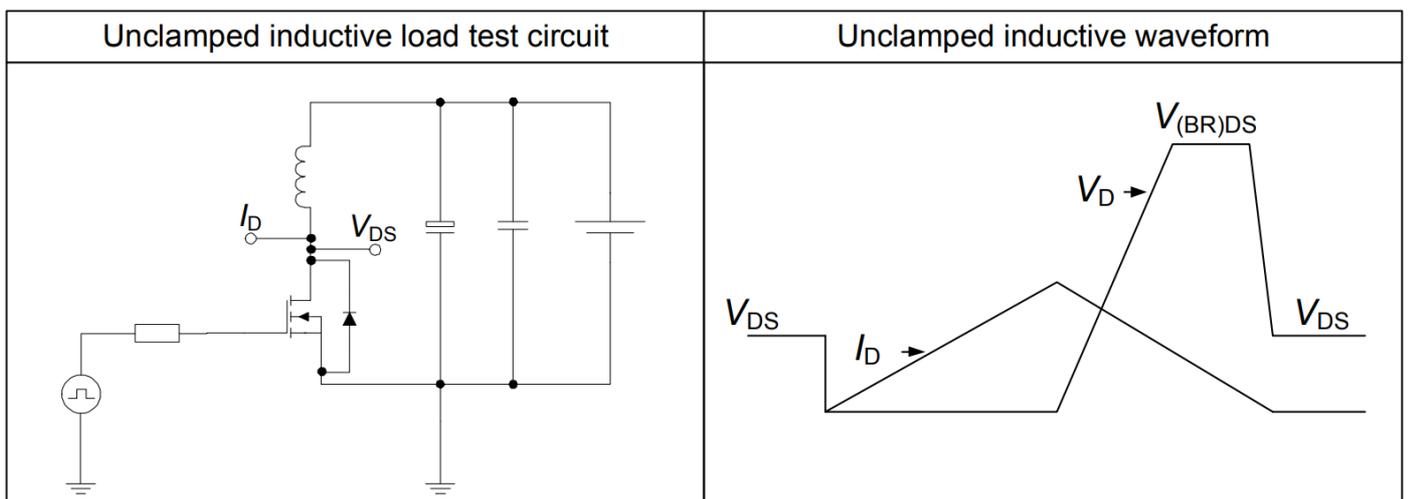


表 16



6 测试电路

表17 二极管特性

表 18 开关时间

表 19 非钳位感性


7 封装外形

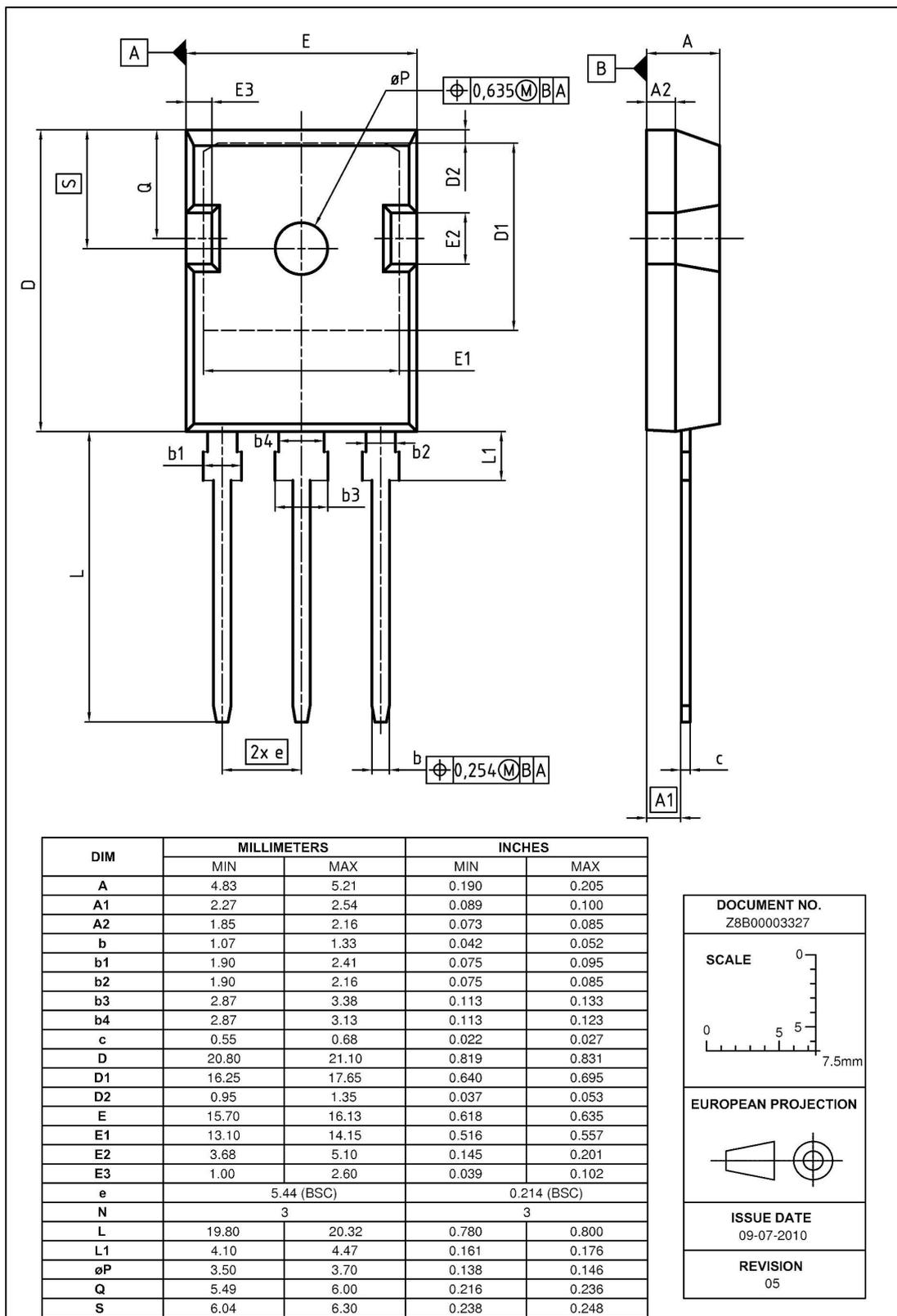


图1 PG-TO 247 封装外形，尺寸单位：毫米/英寸

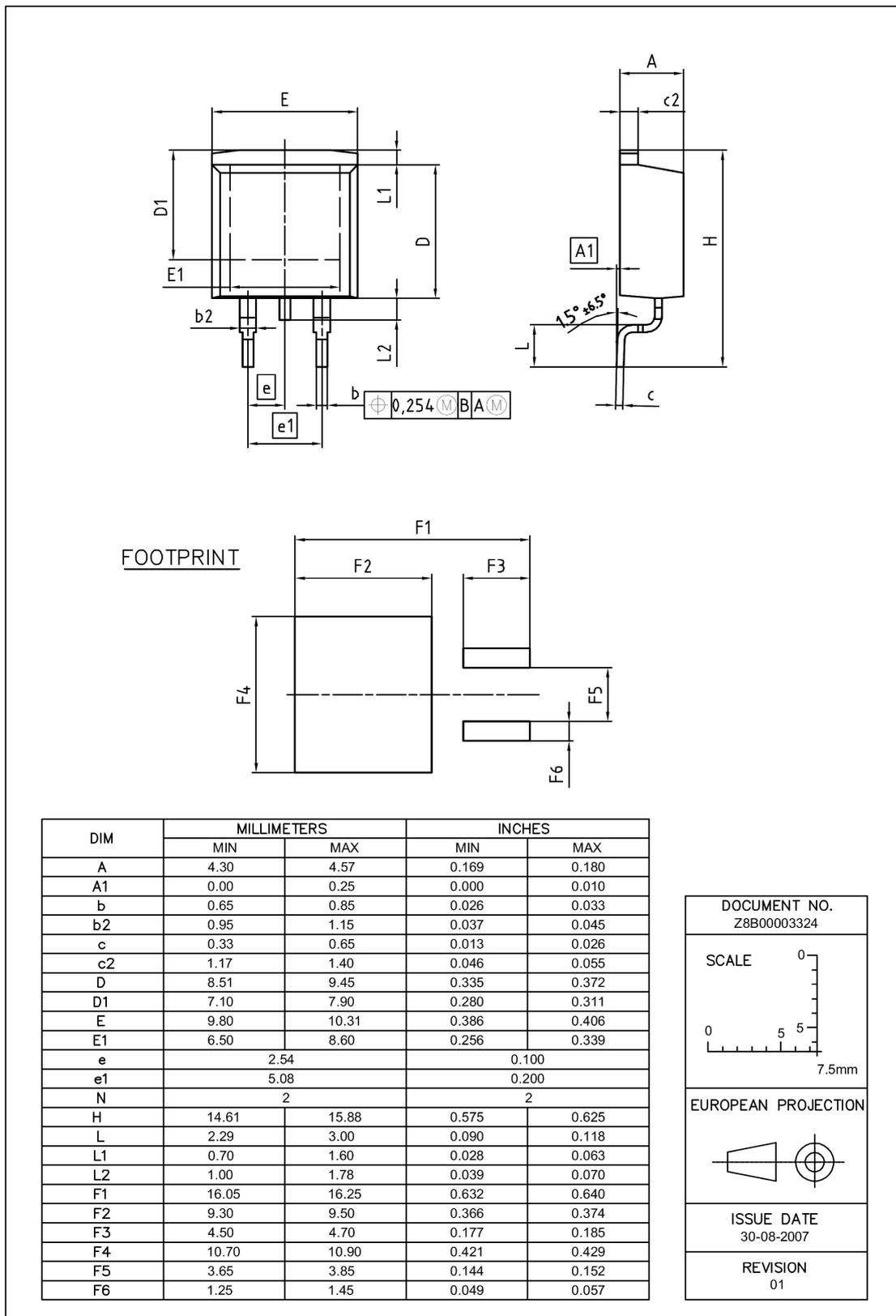


图2 PG-TO 263 封装外形，尺寸单位：毫米/英寸

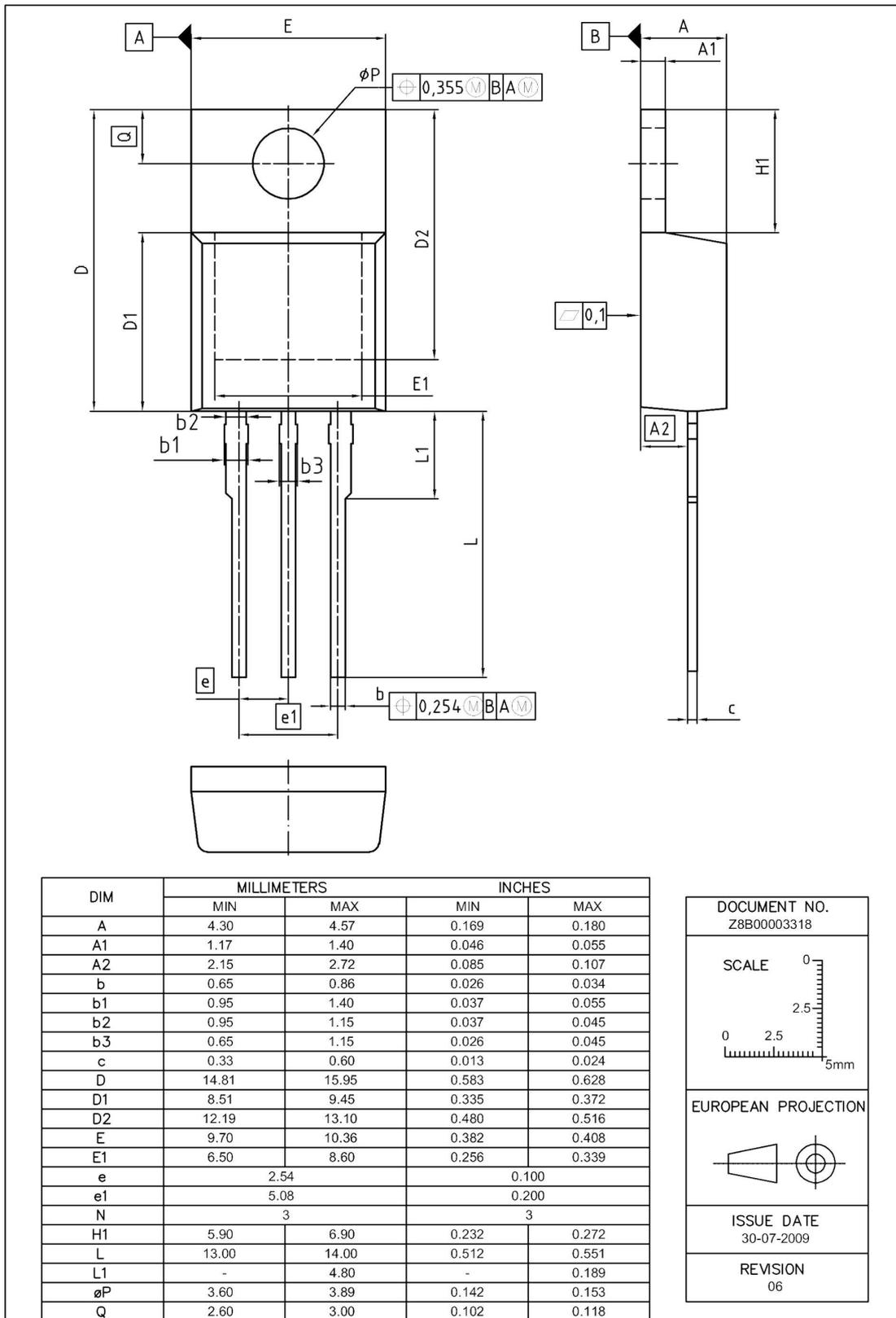


图3 PG-TO 220 封装外形，尺寸单位为毫米/英寸

修订记录

IPW65R110CFDA, IPB65R110CFDA, IPP65R110CFDA

Revision: 2012-03-28, Rev. 2.0

Previous Revision

Revision	Date	Subjects (major changes since last revision)
2.0	2012-03-28	Final datasheet

Disclaimer ATV

We Listen to Your Comments

Any information within this document that you feel is wrong, unclear or missing at all? Your feedback will help us to continuously improve the quality of this document. Please send your proposal (including a reference to this document) to:

erratum@infineon.com

Edition 2011-09-30

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munchen, Germany

© 2011 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffheitsgarantie"). With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies Components may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body, or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life.

If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

重要通知

版本 2026-02-12

Infineon Technologies AG 出版，
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2026 Infineon Technologies AG
及其关联公司。
保留所有权利。

**Do you have a question about this
document?**

Email:
erratum@infineon.com

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担不侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据探勘（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文档包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。